

Содержание

• Обзоры

Кашерининов П.Г., Томасов А.А., Берегулин Е.В. Быстрые оптические регистрирующие среды на полупроводниковых наноструктурах для записи изображений на зарядах свободных фотоносителей	3
--	---

• Неэлектронные свойства полупроводников (атомная структура, диффузия)

Бакулин А.В., Еремеев С.В., Терещенко О.Е., Кулькова С.Е. Адсорбция хлора на поверхности InAs (001)	23
---	----

• Электронные свойства полупроводников

Касумоглу И., Керимова Т.Г., Мамедова И.А. Влияние γ -облучения на электрические свойства CuGaSe ₂	32
--	----

Yildiz A., Tasli P., Sarikavak B., Lisesivdin S.B., Ozturk M.K., Kasap M., Ozelik S., Ozbay E. Grain boundary related electrical transport in Al-rich Al _x Ga _{1-x} N layers grown by metal-organic chemical vapor deposition	34
---	----

Абдуллаев Н.А., Абдуллаев Н.М., Алигулиева Х.В., Керимова Т.Г., Мехдиев Г.С., Немов С.А. Особенности механизма переноса заряда в слоистых монокристаллах Bi ₂ Te ₃ , легированных хлором и тербием	38
--	----

Даунов М.И., Ковалев А.С., Моллаев А.Ю., Магомедов А.Б. О резонансном донорном уровне в <i>n</i> -CdTe по данным об электронном транспорте при всестороннем давлении	44
--	----

Гаджиалиев М.М., Камилов И.К., Пирмагомедов З.Ш. Термостимулированный переход между примесной и собственной проводимостями	48
--	----

Грушка О.Г., Чупыра С.М., Мыслюк О.М., Биличук С.В., Заболоцкий И.И. Проводимость кристаллов Hg ₃ In ₂ Te ₆ в сильных электрических полях	50
--	----

Тагиев Б.Г., Тагиев О.В., Асадуллаева С.Г. Вольт-амперные характеристики поликристаллов соединения ZnGa ₂ Se ₄	53
--	----

• Поверхность, границы раздела, тонкие пленки

Нежданов А.В., Филатов Д.О., Антонов Д.А., Зубков С.Ю., Машин А.И., Ершов А.В. Морфология, электронная структура и оптические свойства самоформирующихся кремниевых наноструктур на поверхности высокоориентированного пиролитического графита	57
--	----

Богатыренко В.В., Зиновчук А.В. Измерение скорости поверхностной рекомбинации и объемного времени жизни в пластинах Si по кинетике избыточного теплового излучения	62
--	----

Кюрегян А.С. О максимальной толщине области пространственного заряда обратносмещенных <i>p</i> ⁺ - <i>n</i> -переходов с положительной фаской	67
--	----

• Полупроводниковые структуры, низкоразмерные системы, квантовые явления

Торхов Н.А., Новиков В.А. Влияние периферии контактов металл-полупроводник с барьером Шоттки на их электрофизические характеристики	70
---	----

Корнаухов А.В., Ежевский А.А., Марычев М.О., Филатов Д.О., Шенгуров В.Г. О природе электролюминесценции в режиме пробоя при обратном смещении на длине волны 1.5 мкм для легированных эрбием кремниевых структур с <i>p-n</i> -переходом, полученных методом сублимационной молекулярно-лучевой эпитаксии	87
---	----

Nemcsics Ákos, Takács Jenő Modeling of the hysteretic phenomena in RHEED intensity variation versus temperature for GaAs and InAs surfaces	93
--	----

Шамирзаев Т.С. Полупроводниковые гетероструктуры первого рода с непрямой зоной проводимости	97
---	----

Ваганов С.А., Сейсян Р.П. Температурно-зависимое экситонное поглощение в длиннопериодных структурах множественных квантовых ям In _x Ga _{1-x} As/GaAs	104
--	-----

Гавриленко В.И., Криштопенко С.С., Goigap M. Электрон-электронное и спин-орбитальное взаимодействие в гетероструктурах InAs/AlSb с двумерным электронным газом	111
--	-----

• Аморфные, стеклообразные, органические полупроводники

Бабаев А.А., Султанов С.Б., Абдулвагабов М.Ш., Теруков Е.И. Электрические, оптические и механические свойства аморфного гидрогенизированного углерода, полученного при различных условиях осаждения	120
---	-----

● **Микро- и нанокристаллические, пористые, композитные полупроводники**

Сычикова Я.А., Кидалов В.В., Сукач Г.А.

Влияние дислокаций на процесс порообразования в монокристаллах n -InP(111) 123

Крылов П.Н., Романов Э.А., Федотова И.В.

Влияние термоотжига на структуру нанокристаллических пленок сульфида цинка 127

● **Изготовление, обработка, тестирование материалов и структур**

Кузнецов В.П., Шмагин В.Б., Дроздов М.Н., Марычев М.О., Кудрявцев К.Е., Кузнецов М.В., Андреев Б.А., Корнаухов А.В., Красильник З.Ф.

Зависимость концентрации ионизованных доноров от температуры эпитаксии для слоев Si:Er/Si, выращенных методом сублимационной молекулярно-лучевой эпитаксии . . . 132

Бойко В.М., Веревкин С.С., Колин Н.Г., Корулин А.В., Меркурисов Д.И., Поляков А.Я., Чевычелов В.А.

Влияние нейтронного облучения и температуры отжига на электрофизические свойства и период решетки эпитаксиальных слоев нитрида галлия 136